

关键指标

频率范围：8~12GHz
移相范围：360°，LSB = 5.625°
移相精度均方根：1.5°
插入损耗：9.5dB
电压/电流：-5V/5mA
控制电平：0/+5V
芯片尺寸：3.25mm×1.25mm

产品简介

HG165YA 是一款 8~12GHz 六位数控移相器芯片，插入损耗为 9.5dB，移相精度均方根为 1.5°，输入输出驻波比为 1.3/1.5。

电性能 (T_A=25°C, VEE=-5V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	8~12		
输入驻波	-	1.3	-
输出驻波	-	1.5	-
插入损耗(dB)	-	9.5	-
幅度波动(dB)	-	±1	-
移相精度(°)	-	-4~4	-
移相精度均方根(°)	-	1.5	-
静态电流(mA)	-	5	-

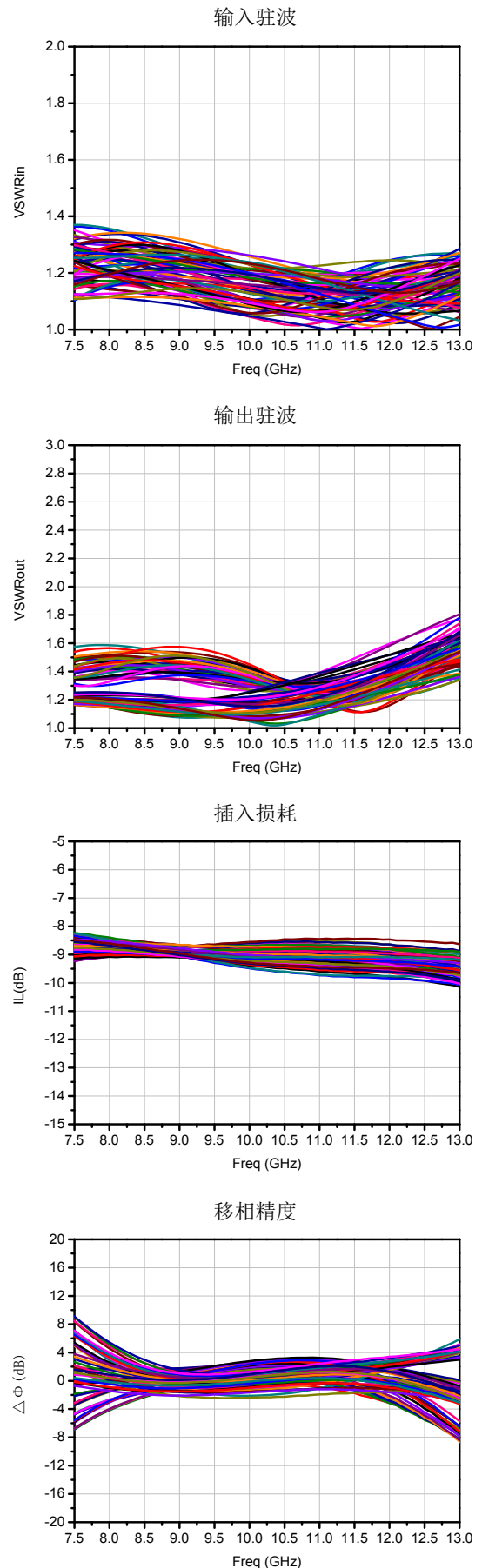
真值表 (VEE=-5V, 0: 0V, 1: +5V)

状态	C1	C2	C3	C4	C5	C6
零态	0	0	0	0	0	0
-5.625°	1	0	0	0	0	0
-11.25°	0	1	0	0	0	0
-22.5°	0	0	1	0	0	0
-45°	0	0	0	1	0	0
-90°	0	0	0	0	1	0
-180°	0	0	0	0	0	1
-354.375°	1	1	1	1	1	1

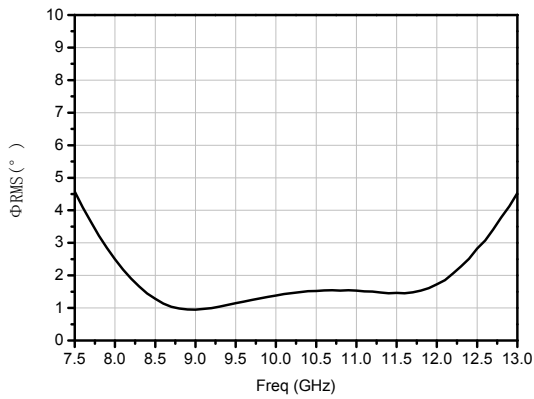
绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
电源电压	-5.5V	
控制电平	低电平：0~0.5V	高电平：3.7~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

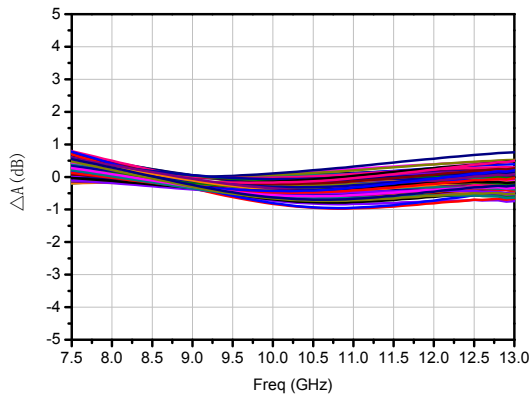
典型测试曲线



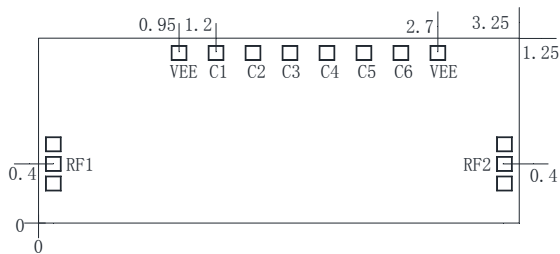
移相精度均方根



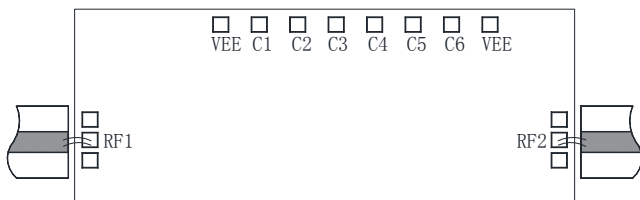
幅度波动



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。